



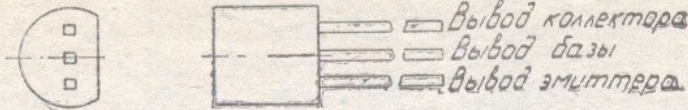
Транзисторы КТ209А, КТ209Б, КТ209В,
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж,
КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М

54

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М в пластмассовом корпусе предназначены для работы в линейных и импульсных схемах, в блоках телевизионных приемников.

Схема расположения выводов



Обозначение типа транзистора — условная маркировка «◆» белой краской согласно таблице.

Таблица условной маркировки транзисторов типа КТ209

Тип транзистора		Группа транзистора		Год выпуска		Месяц выпуска	
Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка
КТ209	◆	А	А	1987	V	январь	1
		Б	Б	1988	W	февраль	2
		В	В	1989	X	март	3
		Г	Г	1990	A	апрель	4
		Д	Д	1991	B	май	5
		Е	Е	1992	C	июнь	6
		Ж	Ж	1993	D	июль	7
		И	И	1994	E	август	8
		К	К	1995	F	сентябрь	9
		Л	Л	1996	H	октябрь	0
		М	М	1997	I	ноябрь	N

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер (при заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер $R_{БЭ}=10\text{кОм}$). В при $I_k=1\text{мкА}$ КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	$U_{кЭР}$ проб	—15 —30 —45 —60	— — — —
Пробивное напряжение эмиттер-база, В при $I_B=1\text{мкА}$ КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	$U_{ЭБ}$ проб	—10 —20	— —
Статический коэффициент передачи тока $U_{кЭ}=-1\text{В}$, $I_k=30\text{мА}$ КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л, КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М, КТ209В, КТ209Е, КТ209К	$h_{21Э}$	20 40 80 80	60 120 240 160
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $I_k=300\text{мА}$, $I_B=30\text{мА}$ КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	$U_{кЭнас}$	—	0,4
Напряжение насыщения база-эмиттер, В $I_k=300\text{мА}$, $I_B=30\text{мА}$ КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	$U_{БЭнас}$	—	1,5

Содержание драгоценных металлов.

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:

золото — 0,9556 мг. Содержание цветных металлов.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М соответствуют техническим условиям А0.336.065 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Перепроверка произведена

ОТК-48

(дата)

Место для штампа ОТК